



報道発表

2010年9月7日

報道関係者各位

eBeam Initiative のメンバー会社が SPIE/BACUS Symposium 2010 で協業の成果を発表

新たに4社が eBeam Initiative に参加

(米国 San Jose 発)設計から製造への革新的アプローチである Design for e-Beam (以下 DFEB) を普及、促進することを目標としたフォーラム eBeam Initiative は、本日、最先端リソグラフィー・マスク技術の世界最高の技術会議・展示会のひとつである SPIE/BACUS Symposium 2010 において、幾つかのイニシアチブメンバーが共同で DFEB マスク技術の最新の画期的な成果について報告すると発表しました。これらの共同成果報告は、22nm ノード以降の先端フォトマスクに対する DFEB マスク技術の有効性を示すものです。SPIE/BACUS Symposium 2010 は、カリフォルニア州モンレーのマリオット・ホテルで9月13日-16日に開催されます。

さらに、eBeam Initiative は、4つの新しい会社がメンバーに加わったことを発表いたしました。これらの4社-Abeam Technologies, EQUIcon Software GmbH Jena, Synopsys および TOOL 株式会社のイニシアチブへの参加は DFEB マスク・テクノロジーの商業化をサポートするために不可欠な、エコシステム(関連技術・事業)の強化という点で極めて重要です。

Aki Fujimura (D2S CEO 及び eBeam Initiative の事務局長)

「eBeam Initiative メンバー各社の協力によって、私たちの DFEB マスク技術はロードマップに沿って発展し続けています。今回の SPIE/BACUS Symposium でメンバー各社は、初めて、重なりを持つ電子ビームショットを使用することによって曲線パターンの描画ショット数が削減できることを実証します。また、新たに4社が Initiative に加入したことを非常に光栄に思います。半導体産業に関連している企業の間で、22nm ノード以降の複雑なマスクをコスト効率良く製造することを可能にする DFEB テクノロジーの重要性の認識はますます高まっています。」

22nm ノードでのデバイス製造のためにはマスク・リソグラフィーに曲線パターンを使うことが決定的に重要になります。DFEB マスク技術は電子ビームの角が丸くなる特性を利用して、複雑で曲線的なパターンを実用的なターンアラウンドタイムで描画できる、費用対効果に優れた光リソグラフィーを現実のものにします。eBeam Initiative メンバーからの共同開発結果は従来の電子ビーム描画技術と比較して、最先端露光マスクをより少ないショット数とより短い描画時間で行えることを示しています。

SPIE/BACUS Symposium2010 で eBeam Initiative メンバーは以下の論文を発表する予定です。

9月14日

- 午前 10 時 40 分: セッション2: Pattern Generation (Invited Paper)

“Improvement of Mask Write Time for Curvilinear Assist Features at 22nm”

- 午後 1 時 20 分: セッション6: Mask Data Preparation

“Writing 32-nm-HP Contacts with Curvilinear Assist Features”

- 午後 5 時 50 分: セッション8: Optical Proximity Correction

“Impact of Model-Based Fracturing on Proximity Effect Correction Methodology”

9 月 15 日

- 午前 8 時 00 分: 特別セッション: EBDR/ML2 (セッション9A)

(招待講演)Aki Fujimura, D2S CEO “ Design for e-beam: design insights for direct-write maskless lithography”

これらの共同開発成果報告に加えて、eBeam Initiative は SPIE/BACUS Symposium 会場で行われる“MCA BrightSpots リソグラフィー・パネル”を共同開催致します。このパネル討論の実演は9月14日(火)午後5時15分から、ホテル内の San Carlos Ballroom I で開催され、終了後交流会が行われます。本イベントへの参加申込みは dmoreno@mcapr.com 宛に行ってください。また、会場のパネルに参加できない方は <https://www2.gotomeeting.com/register/871337162> に登録することにより、Web 上で参加することができます。

SPIE/BACUS Symposium2010 での eBeam Initiative の活動内容に関しては、www.ebeam.org をご参照下さい。

eBeam Initiative について

eBeam Initiative は、design for e-beam (DFEB)として知られる革新的な設計から製造へのアプローチを普及、促進することを目標としたフォーラムです。DFEB は、設計、設計ソフトウェア、製造、製造装置、および製造ソフトウェアの専門技術を組み合わせ、半導体のマスク費用を削減します。このイニシアティブのゴールは、IC の設計数を増やし、タイムトゥマーケットを短縮し、業界における DFEB 採用の障壁を減らすと同時に、半導体業界全体への投資を拡大することです。本イニシアティブは、メンバー企業、アドバイザー、およびステアリング委員会から構成され、半導体関連の全分野の機関が参加しており、米 Abeam Technologies、株式会社アドバンテスト、台湾 Alchip Technologies、米 Altos Design Automation、独 AMTC、米ケイデンス・デザイン・システムズ、仏 CEA/Leti、米 D2S 社、大日本印刷株式会社、Martin M. Deneroff 氏、独 EQUIcon Software GmbH Jena 社、株式会社イー・シャトル、米 eSilicon Corporation 社の Jack Harding 氏、米 Fastrack Design 社、独 Fraunhofer CNT、富士通セミコンダクター株式会社、独 GenISys GmbH 社、米グローバルファンドリーズ社、HOYA 株式会社、日本電子株式会社(JEOL)、米 KLA-Tencor 社、米マグマ・デザイン・オートメーション社、株式会社ニューフレアテクノロジー、米 Petersen Advanced Lithography 社、米 PMC-Sierra 社の Colin Harris 氏、米クアルコム社の Riko Radojcic 氏、韓国サムスン・エレクトロニクス社、仏 STMicroelectronics 社、米 Synopsys 社、米 Tela Innovations 社、Tool 株式会社、凸版印刷株式会社、米 Virage Logic 社、独 Vistec Electron Beam Lithography Group が含まれます。また、本イニシアティブは、エレクトロニクス業界におけるあらゆる企業および機関に対し、幅広く参加を募っています。URL:www.ebeam.org.

本件に関するご連絡先:

株式会社 D2S

河内一往

Tel: 045-479-8390

E-mail: kazu@design2silicon.com

D2S Inc.

James Fong

Tel: +1-408-781-9017

E-mail: jfong@design2silicon.com

MCA

David Moreno

Tel: +1-650-968-8900, ext. 125

E-mail: dmoreno@mcapr.com

本報道発表内で提供されている情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。